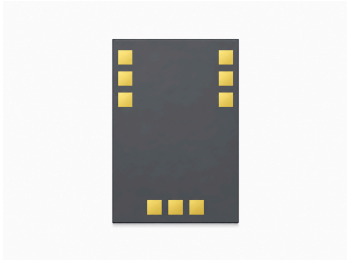


10000–20000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 30 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.2 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.2 (typisch). Chipabmessungen: 0.9 × 1.3 × 0.1 mm.



RF-Kennwerte · TA = +25 °C

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Wert	Einheit
Betriebsfrequenz	-	10000	-	20000	10000–20000	MHz
Isolation	-	-	30	-	-	dB
Eingangs-VSWR	-	-	1.2	-	-	-
Ausgangs-VSWR	-	-	1.2	-	-	-

Grenzwerte

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Maximale Eingangsleistung	-	-	-	30	dBm

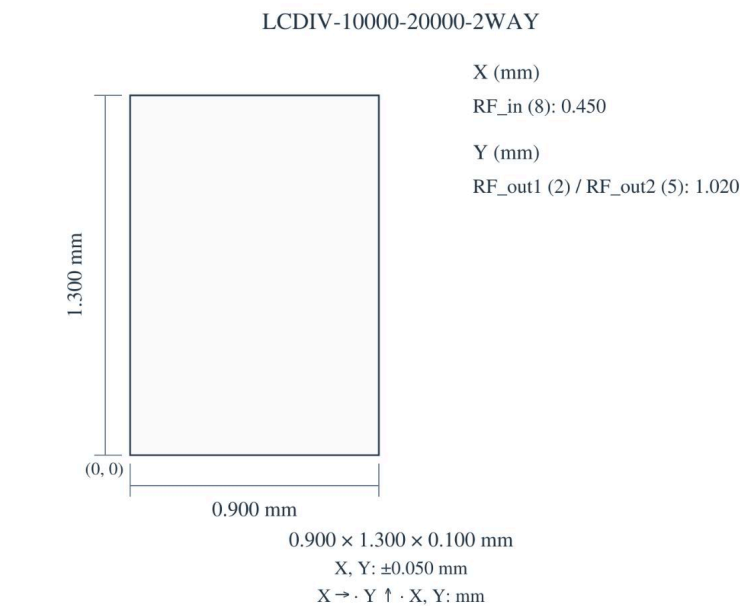
Umgebungsbedingungen

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Lagertemperatur	-	-65	-	150	°C
Betriebstemperatur	-	-55	-	85	°C

Chipabmessungen

Parameter	Wert	Einheit
Chipabmessungen	$0.9 \times 1.3 \times 0.1$	mm

Mechanische Maßzeichnung



Alle Maße in mm [in].

Bondpad-Belegung

Anschlüsse	Symbol	Funktion	Hinweise
1, 3, 4, 6, 7, 9	GND	Masse; kein Bonddraht erforderlich	-
2	RFout1	RF-Ausgang	1
5	RFout2	RF-Ausgang	2
8	RFin	RF-Eingang	-

Aktueller Publikationsstand · 1.3 · 2026-10-27. Produktbeschreibung oder redaktionelle Inhalte wurden aktualisiert. Ersetzt Revision 1.2.

Geltungsbereich der mechanischen Referenz

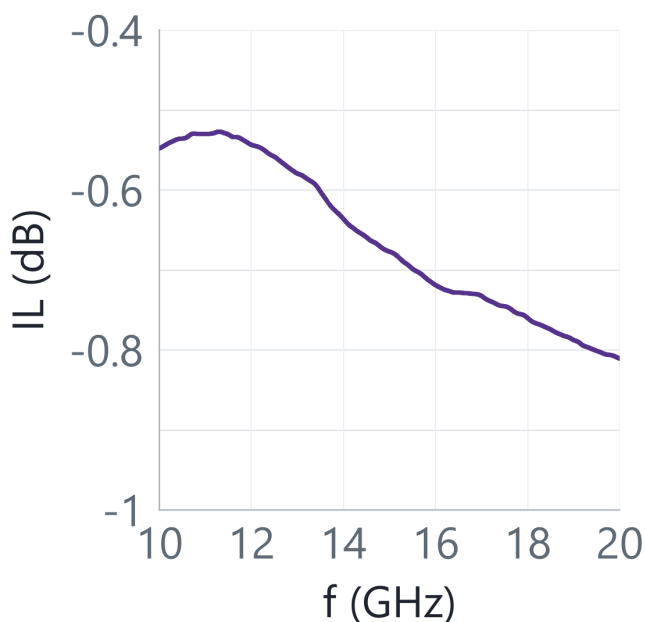
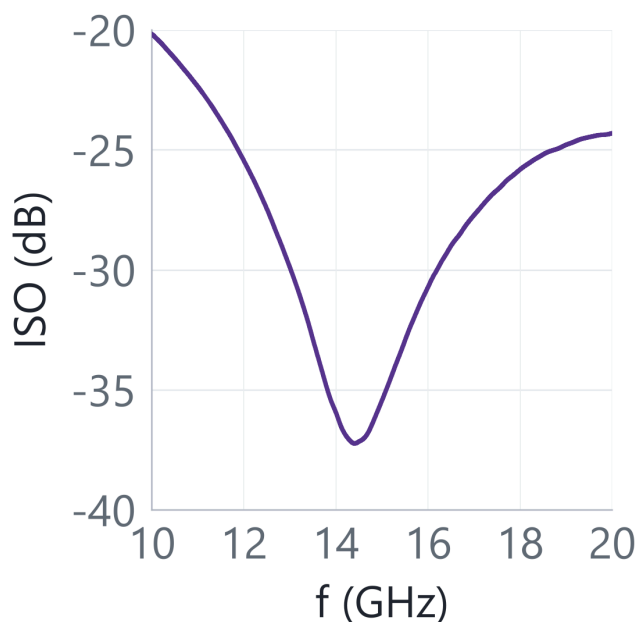
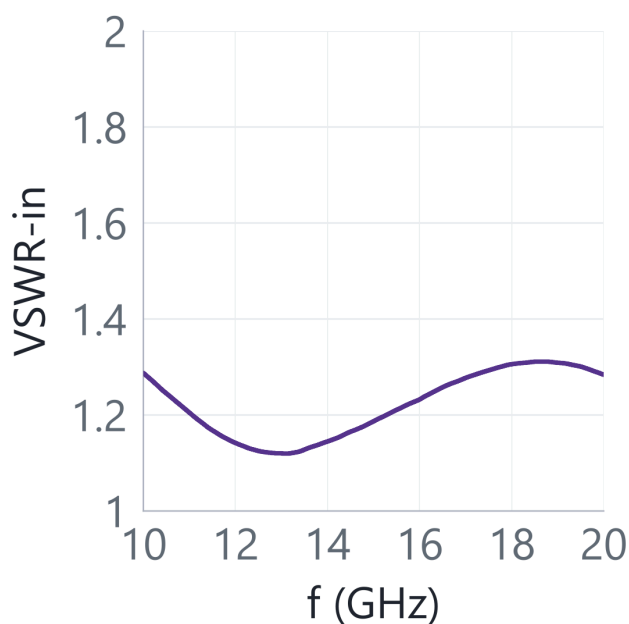
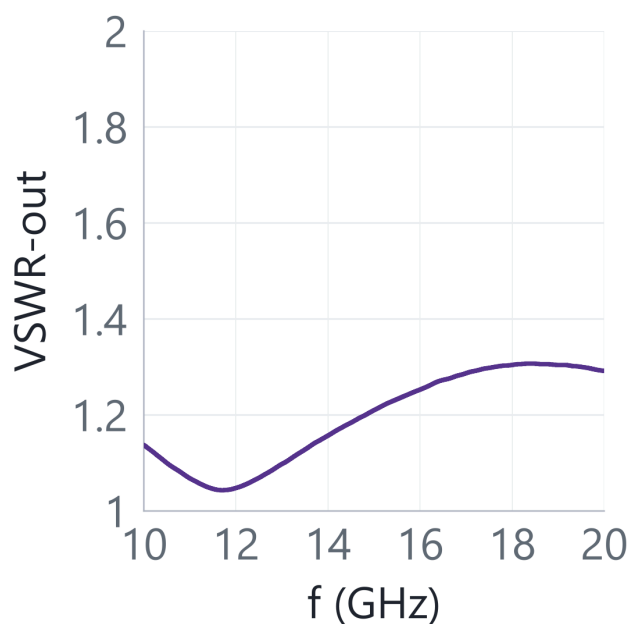
Maßskizze nach Quelldokumentation in mm. Teilinformationen; keine vollständige Fertigungs- oder Bonddrahtzeichnung.

Kennlinien

Diagramme aus dem ursprünglichen Datenblatt. Beachten Sie die bei jeder Abbildung angegebenen Betriebsbedingungen.

Einfügedämpfung; Isolation; Eingangsanpassung; Ausgangsanpassung.

Nach der Originalgrafik neu gezeichnet; die ablesbaren Werte sind Näherungswerte.



[Quelle](#)

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.